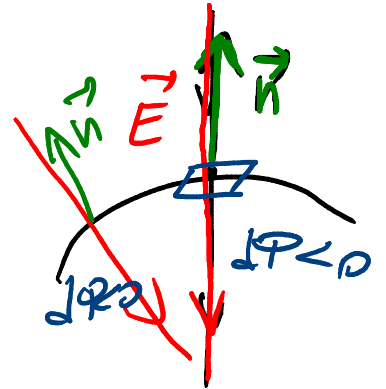
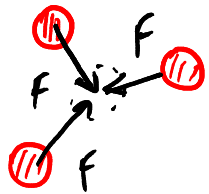


3.7. Теорема Уришоу.

Не существует такой конфигурации неподвижных зарядов (конечного числа), которая была бы устойчивой, если нет других сил, кроме сил кулоновского взаимодействия между зарядами системы.



Док-во. Пусть такая конф-я \exists . Тогда при смещении \forall заряда, возникает сила, возвращ-я его на место.



Тогда силовые линии или, экв. остальными зарядами пройдут радиально к точке равновесия заряда.

$$\oint_{\xi} \vec{E} \perp \vec{\xi} < 0$$

По Т. Лагсса внутри поверхности, окружающей точку
равновесия должен находиться заряд ($\neq 0$).

Но там его нет \Rightarrow противоречие.

З.Т.Г.

Глава 4. Проводники в электростатическом поле.

4.1. Эл. поле в веществе

Эл. поле в вве

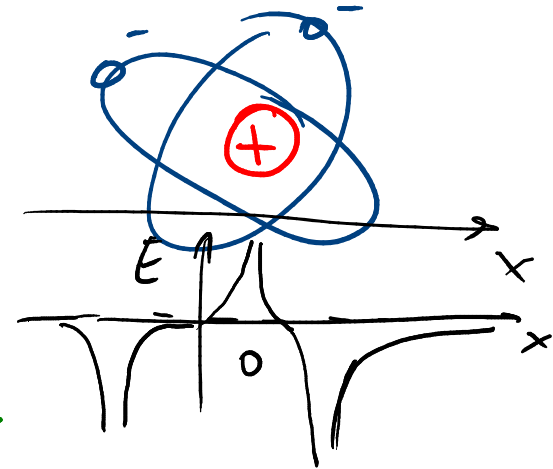
микрполе

(истинное поле)

- 1) поле от всех зарядов в вве
- 2) изм.-ся очень резко
- 3) Рассчитать не реально
- 4) Использовать не возможно
(на макроуровне)

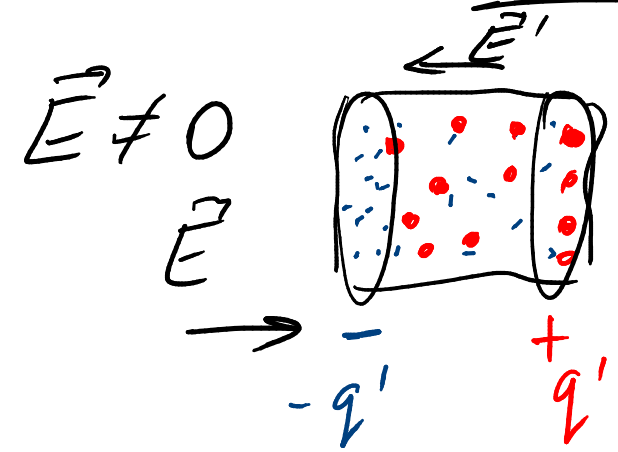
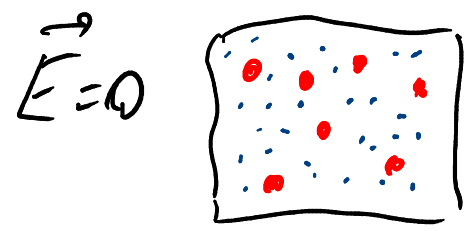
макрополе

- эл. поле, усредненное по физически бесконечно малому объему.
Такой объем мал, но ср. с размерами макрообъекта, но должен включать достаточно большое количество атомов, так чтобы поле изм. плавно.



В в-ве:

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{макро}} = \langle \vec{E}_{\text{микро}} \rangle$$



При внесении в-ва в эл. поле происходит разделение эл. зарядов

Локаль. локально не компенсируются эл. заряды.

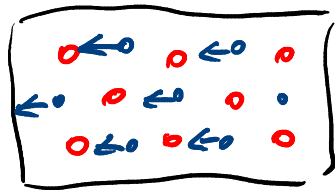
Явление - эл. стат. индукция.

Соотв. некомпенсированные заряды - индуцированные заряды.

4.2. Поле внутри проводника.

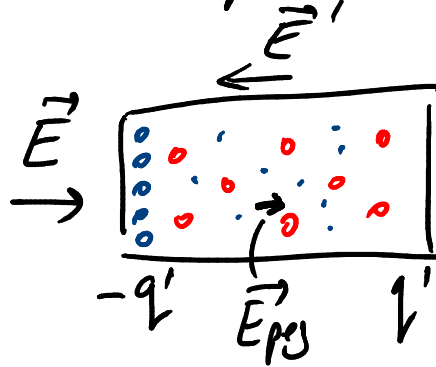
Проводники — в-ва, электроны в которых могут двигаться почти свободно. (как следствие, они хорошо проводят эл. ток).

Поместим проводник (незаряд.) в эл. поле \vec{E} .



$$\vec{E}' \updownarrow \vec{E}$$

Электроны, могут двигаться против поля.



Поса $\vec{E}_{рез} \neq 0$, e^- движется против него.

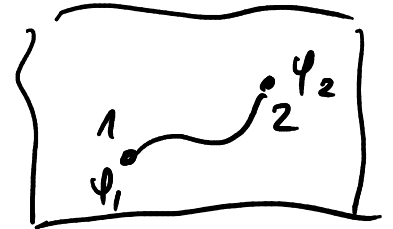
Возникает внутреннее поле \vec{E}' , вызванное инд. зарядами q' .

$$\vec{E}_{рез} = \vec{E} + \vec{E}'$$

В итоге $\vec{E}_{\text{рез}} = 0 \Rightarrow$ Т.О. внутри проводника.

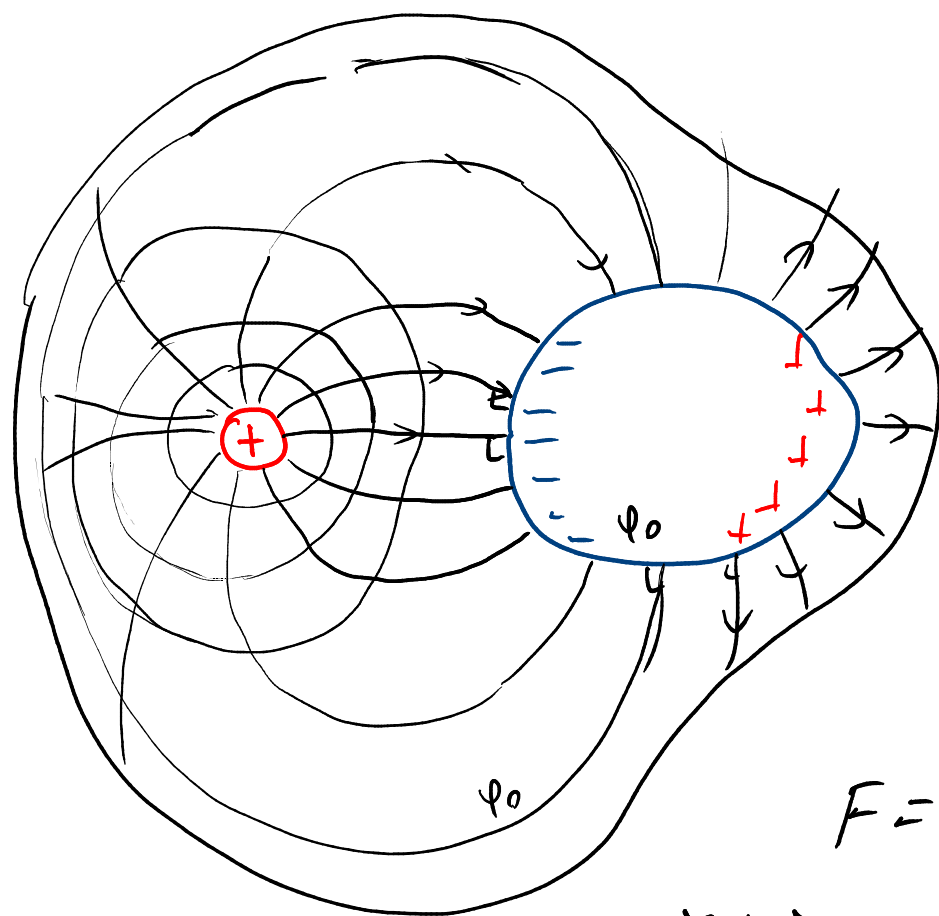
т.е. поле равно нулю.

Рассм. т.е. потенциал. $\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}$

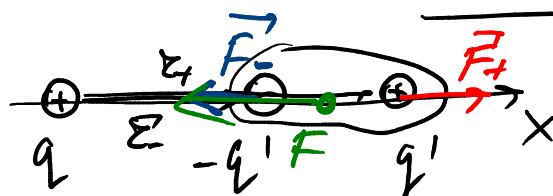


Т.к. $\vec{E} = 0$ внутри проводника, то $\varphi_1 = \varphi_2$ \forall точек 1 и 2 внутри проводника.

Любой проводник является эквипотенциальной областью,
а его поверхность — т.е. поверхность.



$$q_+ = q'; \quad q_- = -q';$$



$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_-;$$



Рассм. 1D сфера.

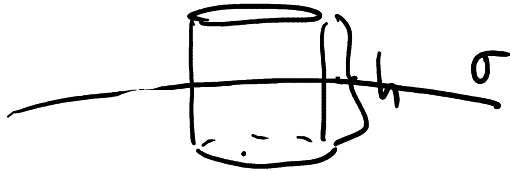
$$F_+ = k \frac{q q'}{z_+^2}; \quad F_- = k \frac{q q'}{z_-^2};$$

$$F = F_+ - F_- = k q q' \left(\frac{1}{z_+^2} - \frac{1}{z_-^2} \right);$$

$z_+ > z_- \Rightarrow F < 0 \Rightarrow$ т.о. необходимо притягивается к плоскости.

4.3. Эл. поле у поверхности проводника.

Рассм. участок поверхности проводника с пов.плотн. заряда σ .



$\sigma \neq 0$; 1) Эл. стат. индукция.

2) Сторонний заряд.

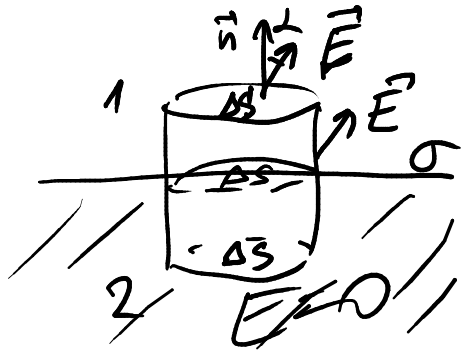
⊗ Сторонний заряд распр. по поверхности проводника, т.е. $E_{\text{рез}} = 0$.

Применяем Т. Гаусса.

Выберем цилиндр в качестве поверхности инт-ла.

Ось \parallel поверхности, высота h — мала

Основания малы, т.е. $E \sim \text{const}$ на основаниях



$$\Phi = \Phi_{\text{очн1}} + \Phi_{\text{очн2}} + \Phi_{\text{бок}}$$

$$\underline{h \rightarrow 0} \Rightarrow \underline{\Phi_{\text{бок}} = 0}$$

$$\Phi_{\text{очн1}} = \int_{\text{очн1}} \vec{E} d\vec{S} = E \int_{\text{очн}} \cos \alpha \cdot dS = E \cos \alpha \cdot S_{\text{очн}} = E_n \cdot \Delta S$$

$$\Phi_{\text{очн2}} = 0 \Rightarrow \Phi = E_n \Delta S;$$

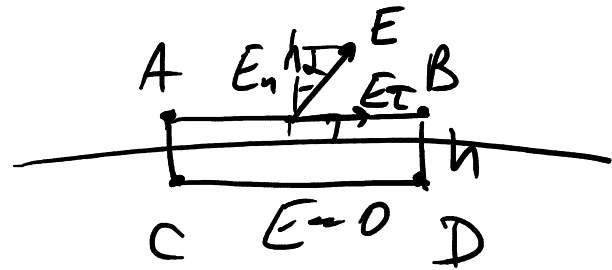
$$Q = \sigma \Delta S \Rightarrow E_n \Delta S = \sigma \Delta S / \epsilon_0$$

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

норм. сост. поле
у пов-сти
проводника

Для нахождения E_{σ} рассм. Т.о. циркуляции Эл.стат. поле.

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = 0$$



Контур $L = ABCD$; $AB \parallel CD \parallel \text{ноб-см}$, а $AC = BD = h$

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = \int_{AB} \vec{E} d\vec{l} + \int_{CD} \vec{E} d\vec{l} + \int_{AC} \vec{E} d\vec{l} + \int_{BD} \vec{E} d\vec{l};$$

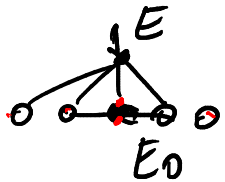
AB - мало, т.е.
 $E \in \text{const}$ в это
 пределах

При $h \rightarrow 0$; $\int_{AC} \rightarrow 0$; $\int_{BD} \rightarrow 0$;

$$\int_{AB} \vec{E} d\vec{l} = E \int_{AB} \sin \alpha dl = E \sin \alpha \int_{AB} dl = E_{\sigma} \underline{l_{AB}}$$

$$E_{\tau} l_{AB} = 0 \Rightarrow$$

$$E_{\tau} = 0$$



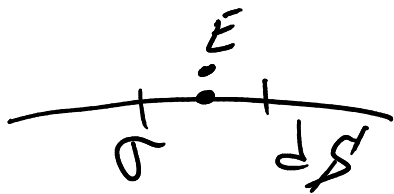
В итоге $E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$; $E_{\tau} = 0$; $\Rightarrow \vec{E} \perp$ пов-ти

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

4.4. Сила, действующая на поверхность проводника.

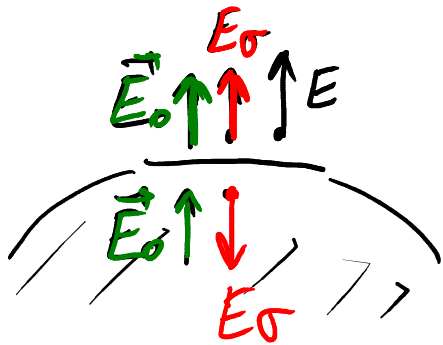
напр. эл. поле у пов-ти проводника.

Рассм. dS - элем. пов-ти; заряженной с плотностью σ .



$$d\vec{F} = \sigma dS \vec{E}_0,$$

где \vec{E}_0 - поле, созд. остальными зарядами системы, кроме $dq = \sigma dS$.



Углубит ↓ (созд). поле $E_\sigma = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (поле во-в
срещ. плоскости)

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} - \text{снаружи проводника}$$

Поле $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_\sigma$;

и $E = 0$ внутри.

Снаружи: $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = E_0 + E_\sigma$;

внутри: $E = 0 = E_0 - E_\sigma$

$E_0 = E_\sigma$

$E_0 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$;

$\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

\Rightarrow $\vec{E}_0 = \frac{1}{2} \vec{E}$.

Тогда $d\vec{F} = \sigma dS \frac{1}{2} \vec{E} = dS \cdot E \epsilon_0 \frac{1}{2} \vec{E} = dS \cdot \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \vec{n}$

$$\vec{f} = \frac{d\vec{F}}{dS} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \vec{n} = \frac{\sigma^2 \vec{n}}{2\epsilon_0}$$

Поверхностная
плотность силы (удельная сила),
действующей на проводник.
 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

4.5. Метод электрических изображений.

Основная задача эл. статики - поиск $\vec{E}(\vec{r})$ при заданной конфигурации зарядов $\{q_i\}$ или $\rho(\vec{r})$.

Способы решения:

4) Уре Пуассона, $\vec{E} = -\nabla\varphi$

1) Закон Кулона и принцип суперпозиции.

2) Т. Гаусса. (Т.о циркуляции)

3) φ по суперпозиции и $\vec{E} = -\nabla\varphi$

Заряд и проводящая плоскость.

